



<b>Title of Change:</b>	Capacity expansion of Assembly and Test operations of DPAK manufacturing additional site to GEM China										
<b>Proposed First Ship date:</b>	8 January 2020										
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.Support@onsemi.com >										
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.										
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>										
<b>Change Part Identification:</b>	The trace code on Line 1 is of the form ZYWK where Z = Assembly Location, YW is a 3-digit date code and K is traceability code. Product marked with "M" as the assembly location will be from GEM. Additionally on the label of the box and reel, the ASSY LOC: PO will also indicate product assembled in GEM. Please see sample label on Page 2 at the following URL <a href="http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF">http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF</a> to see the location of the ASSY LOC.										
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____										
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____										
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: ON Suzhou, China	External Foundry/Subcon Sites: GEM China									
<b>Description and Purpose:</b>											
<p>This Notification announces to customers ON Semiconductor's plans to expand Assembly and Test operations of former Fairchild DPAK Packaged products to an existing external manufacturing site in GEM china. This is a capacity expansion, and at the end of the FPCN approval cycle, these products may be dual sourced from either GEM, China or from On Semi Suzhou, China.</p> <p>DPAK will be qualified and released as part of this expansion in GEM (as per table in List of affected parts). GEM is currently running production for DPAK package. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC</td> <td>EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC ; G700HF/CEL8240HF10FC</td> </tr> <tr> <td>Assembly Site</td> <td>ONSZ</td> <td>ONSZ ; GEM China</td> </tr> </tbody> </table>				Before Change Description	After Change Description	Mold Compound	EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC	EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC ; G700HF/CEL8240HF10FC	Assembly Site	ONSZ	ONSZ ; GEM China
	Before Change Description	After Change Description									
Mold Compound	EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC	EME 6600CS/ KTMCS900GM/ KTMCS400SM/ CEL8240HF10FC ; G700HF/CEL8240HF10FC									
Assembly Site	ONSZ	ONSZ ; GEM China									
There is no product marking change as a result of this change.											

**Qualification Plan:**

It will follow the generic plans shown below based on technology and application:

**QV DEVICE NAME : FQD2N100TM-F101**

**RMS : NA**

**PACKAGE : DPAK**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST

**QV DEVICE NAME: FQD18N20V2TM**

**RMS: NA**

**PACKAGE : DPAK**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST

**QV DEVICE NAME: FDD8647L**

**RMS: NA**

**PACKAGE: DPAK**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST



QV DEVICE NAME: FCD850N80Z

RMS: NA

PACKAGE: DPAK

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85%, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST

QV DEVICE NAME: FDD5N50UTM-WS

RMS: NA

PACKAGE: DPAK

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85%, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST

QV DEVICE NAME: FDD4N60NZ

RMS: NA

PACKAGE: DPAK

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85%, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST



QV DEVICE NAME: FDD390N15ALZ

RMS: NA

PACKAGE: DPAK

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85%, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Note : H3TRB may be instead of by HAST

Estimated date for qualification completion: 30 August 2019

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
SSR1N60BTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD3N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD5N50CTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD5N60CTM	FQD2N100TM-F101
FQD5N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD6N50CTM	FQD18N20V2TM
FQD6N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FDD1600N10ALZ	FDD390N15ALZ
FDD390N15A	FDD390N15ALZ
FDD390N15ALZ	FDD390N15ALZ
FDD86110	FDD390N15ALZ
FDD86250	FDD390N15ALZ
FDD86252	FDD390N15ALZ
FDD86326	FDD390N15ALZ
FDD3860	FDD8647L
FDD5353	FDD8647L
FDD8444	FDD8647L
FDD8451	FDD8647L
FDD8453LZ	FDD8647L
FDD8647L	FDD8647L
FQD1N80TM	FQD2N100TM-F101



FQD2N100TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N90TM	FQD2N100TM-F101
FQD30N06TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM-AM002BLT	FQD2N100TM-F101
FQD4P40TM	FQD2N100TM-F101
FQD5N15TM	FQD2N100TM-F101
FQD7N30TM	FQD2N100TM-F101
FQD18N20V2TM	FQD18N20V2TM
FCD1300N80Z	FCD850N80Z
FCD2250N80Z	FCD850N80Z
FCD3400N80Z	FCD850N80Z
FCD380N60E	FCD850N80Z
FCD600N60Z	FCD850N80Z
FCD620N60ZF	FCD850N80Z
FCD850N80Z	FCD850N80Z
FCD900N60Z	FCD850N80Z
FCD9N60NTM	FCD850N80Z
FDD2572	FDD5N50UTM-WS
FDD2582	FDD5N50UTM-WS
FDD3672	FDD4N60NZ
FDD3682	FDD4N60NZ
FDD10N20LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD18N20LZ	FDD5N50UTM-WS
FDD3N40TM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50FTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50UTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD6N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD6N25TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N25LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD3N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD4N60NZ	FDD4N60NZ
FDD5N50NZFTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N60NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD8N50NZTM	FDD5N50UTM-WS

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22760X

発行日 : 8 July 2019

変更件名:	DPAK 製造における組立および検査 オペレーションの能力を、追加拠点の GEM(中国)に拡大	
初回出荷予定日:	8 January 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Support@onsemi.com> お問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> お問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> お問い合わせください。	
変更部品の識別:	1 行目のトレースコードであるフォーム ZYWK において Z は組立場所、YW は 3 桁の日付コード、K はトレーサビリティコードです。組立場所として「M」がマークされている製品は GEM からのものです。さらに、箱およびリールのラベルに ASSY LOC が記載されています。PO は GEM で組み立てられた製品を示します。以下の URL で 2 ページ目にあるサンプルラベルを参照してください <a href="http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF">http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF</a> で ASSY LOC の場所を参照してください。	
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____	
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Suzhou, China	外部製造工場 / 下請業者拠点: GEM China
説明および目的:	<p>本通知は、以前の Fairchild DPAK パッケージ製品の組立および検査オペレーションの能力を、既存の外部製造拠点である GEM(中国)に拡大するオン・セミコンダクターの計画をお知らせするものです。これによって生産能力が拡大され、FPCN 承認サイクルが完了した時点で、該当の製品は GEM(中国)とオン・セミコンダクター蘇州(中国)のいずれかから供給されるデュアルソースになります。</p> <p>DPAK は、GEM の拡大の一環として認定、そしてリリースされます(対象製品リストの表の通り)。 GEM は現在 DPAK パッケージの製造をおこなっています。認定試験は、移管された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを確認できるように設計されています。</p>	
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	EME 6600CS/ KTMCS5900GM/ KTMCS5400SM/ CEL8240HF10FC	EME 6600CS/ KTMCS5900GM/ KTMCS5400SM/ CEL8240HF10FC ; G700HF/CEL8240HF10FC
組立拠点	ONSZ	ONSZ ; GEM China
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



## 認定計画:

技術およびアプリケーションに基づき以下に示す一般計画に従います。

デバイス名: FQD2N100TM-F101

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの

デバイス名: FQD18N20V2TM

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの

デバイス名: FDD8647L

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80 % max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - 55 °C to + 150 °C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= 150 °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの





デバイス名: FCD850N80Z

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの

デバイス名: FDD5N50UTM-WS

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの

デバイス名: FDD4N60NZ

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated Vgss	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= - <u>55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85% , bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの



デバイス名: FDD390N15ALZ

RMS: NA

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, <u>80</u> % max rated V	<u>1008</u> hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= <u>150</u> °C, 100% max rated V <sub>gss</sub>	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = <u>2</u> min	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Ta= <u>-55</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>1000</u> cyc
H3TRB	JESD22-A101	Ta= <u>150</u> °C, RH=85%, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>1008</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

注: H3TRB は HAST の代わりとなるもの

認定完了予定日: 30 August 2019

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
SSR1N60BTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD3N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD5N50CTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD5N60CTM	FQD2N100TM-F101
FQD5N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD6N50CTM	FQD18N20V2TM
FQD6N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FDD1600N10ALZ	FDD390N15ALZ
FDD390N15A	FDD390N15ALZ
FDD390N15ALZ	FDD390N15ALZ
FDD86110	FDD390N15ALZ
FDD86250	FDD390N15ALZ
FDD86252	FDD390N15ALZ
FDD86326	FDD390N15ALZ
FDD3860	FDD8647L
FDD5353	FDD8647L
FDD8444	FDD8647L
FDD8451	FDD8647L
FDD8453LZ	FDD8647L
FDD8647L	FDD8647L
FQD1N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N100TM	FQD2N100TM-F101



FQD2N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N90TM	FQD2N100TM-F101
FQD30N06TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM-AM002BLT	FQD2N100TM-F101
FQD4P40TM	FQD2N100TM-F101
FQD5N15TM	FQD2N100TM-F101
FQD7N30TM	FQD2N100TM-F101
FQD18N20V2TM	FQD18N20V2TM
FCD1300N80Z	FCD850N80Z
FCD2250N80Z	FCD850N80Z
FCD3400N80Z	FCD850N80Z
FCD380N60E	FCD850N80Z
FCD600N60Z	FCD850N80Z
FCD620N60ZF	FCD850N80Z
FCD850N80Z	FCD850N80Z
FCD900N60Z	FCD850N80Z
FCD9N60NTM	FCD850N80Z
FDD2572	FDD5N50UTM-WS
FDD2582	FDD5N50UTM-WS
FDD3672	FDD4N60NZ
FDD3682	FDD4N60NZ
FDD10N20LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD18N20LZ	FDD5N50UTM-WS
FDD3N40TM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50FTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50UTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD6N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD6N25TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N25LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD3N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD4N60NZ	FDD4N60NZ
FDD5N50NZFTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N60NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD8N50NZTM	FDD5N50UTM-WS